

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 23 年 4 月 14 日 (2011.4.14)

【公開番号】特開 2008-283171 (P2008-283171A)

【公開日】平成 20 年 11 月 20 日 (2008.11.20)

【年通号数】公開・登録公報 2008-046

【出願番号】特願 2008-72639 (P2008-72639)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

H 0 1 L 27/12 (2006.01)

H 0 1 L 21/762 (2006.01)

H 0 1 L 21/764 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 27/08 (2006.01)

G 0 2 F 1/1368 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/12 B

H 0 1 L 21/76 D

H 0 1 L 21/76 A

H 0 1 L 29/78 6 2 7 D

H 0 1 L 27/08 3 3 1 E

G 0 2 F 1/1368

【手続補正書】

【提出日】平成 23 年 3 月 1 日 (2011.3.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】表示装置の製造方法

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

一のパネルを含む面積に分割された複数の単結晶半導体層を、絶縁層を介して絶縁表面を有する基板上に接合し、

前記複数の単結晶半導体層から選択された一のまとまりを同時に露光して回路パターンを形成することにより、個々の前記単結晶半導体層を用いてトランジスタを含む回路を形成することを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項 2】

請求項 1において、

前記絶縁層は、有機シランを原料ガスとして化学気相成長法により成膜する酸化シリコン層であることを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項 3】

請求項 2 において、

前記有機シランとしては、テトラエトキシシラン、トリメチルシラン、テトラメチルシラン、テトラメチルシクロテトラシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、ヘキサメチルジシラザン、トリエトキシシラン、又はトリスジメチルアミノシランを用いることを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかーにおいて、

前記複数の単結晶半導体層から選択された一のまとまりは、露光装置が 1 回に露光する範囲のまとまりとすることを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項 5】

請求項 4 において、

前記露光装置が 1 回に露光する範囲のまとまりは、アライメントマーカを有し、前記アライメントマーカを用いて、前記単結晶半導体層の位置合わせを行うことを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかーにおいて、

前記絶縁表面を有する基板として、アルミノシリケートガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、又はバリウムホウケイ酸ガラス、石英基板、サファイヤ基板、又はセラミック基板を用いることを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項 7】

請求項 1 乃至請求項 6 のいずれかーにおいて、

前記一のパネルのサイズは、対角 10 インチ未満であることを特徴とする表示装置の製造方法。